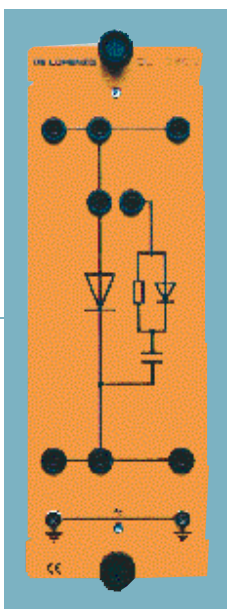


SPECIFICHE TECNICHE



**DL 2602
DIODO AL SILICIO**
Diodo al silicio a recupero rapido adatto a realizzare circuiti raddrizzatori; può essere utilizzato anche come diodo di libera

circolazione nei convertitori.

Caratteristiche tecniche:

Corrente diretta media $I_{FAV} = 12 \text{ A max.}$

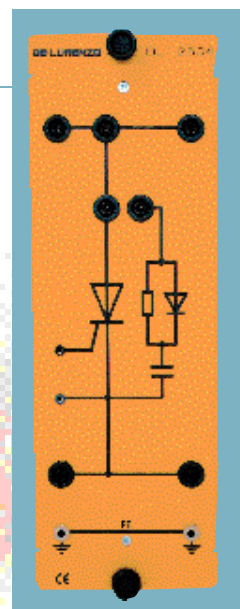
Corrente diretta di sovraccarico non ripetitiva

$I_{FSM} = 75 \text{ A (} t_p = 10 \text{ ms)}$

Tensione inversa di picco ripetitiva

$U_{RRM} = 1000 \text{ V}$

Tempo di recupero inverso $t_{rr} = 65 \text{ ns max.}$



**DL 2604
SCR**

Raddrizzatore controllato al silicio utilizzato nel controllo della potenza, nei raddrizzatori controllati e negli invertitori.

Caratteristiche tecniche:

Corrente diretta media $I_{TAV} = 7,6 \text{ A max.}$

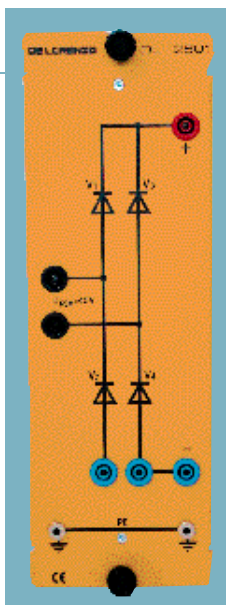
Valore efficace della corrente diretta $I_{TRMS} = 12 \text{ A}$

Max. tensione inversa ripetitiva $U_{RRM} = 800 \text{ V}$

Corrente d'innescio $I_{GT} = 15 \text{ mA max.}$

Tensione d'innescio $U_{GT} = 1,5 \text{ V max.}$

$I^2t = 72 \text{ A}^2\text{s}$



**DL 2601
RADDRIZZATORE AL SELENIO**
Elementi al selenio utilizzati nei raddrizzatori per convertire la corrente alternata in una corrente pulsante in sistemi a bassa tensione.

Caratteristiche tecniche:

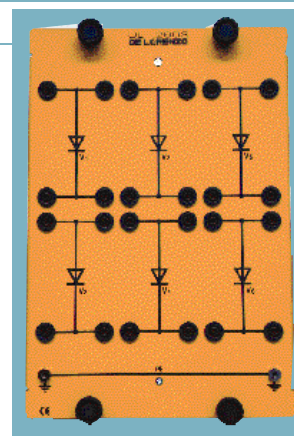
Tensione alternata nominale: 30 Vrms

Tensione continua nominale: 24 Vav

Corrente continua nominale: 10 Aav

**DL 2603
GRUPPO DI
DIODI**

Sei diodi al silicio a recupero rapido con rete RCD di protezione adatti a realizzare circuiti raddrizzatori non controllati.



Caratteristiche tecniche:

Corrente diretta media $I_{FAV} = 12 \text{ A max.}$

Corrente diretta di sovraccarico non ripetitiva

$I_{FSM} = 75 \text{ A (} t_p = 10 \text{ ms)}$

Tensione inversa di picco ripetitiva

$U_{RRM} = 1000 \text{ V}$

Tempo di recupero inverso $t_{rr} = 65 \text{ ns max.}$